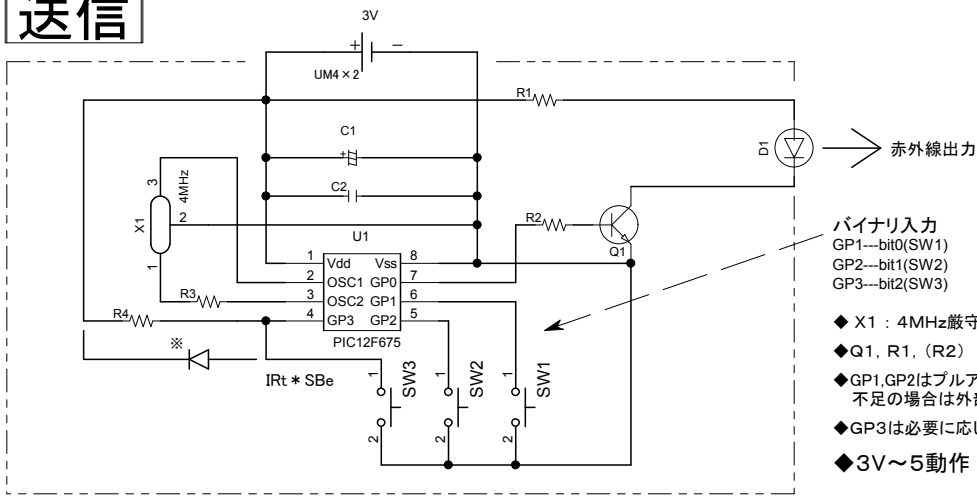


No	品名・名称	型格・コード	数量		
1	マイクロプロセッサ	IRtSBe or IRt2SBe (PIC12F675)	1	わたなべ企画(マイクロチップテクノロジー)	U1
2	トランジスタ	2SC-1213A 他	1	日立 (代替可)	Q1
3	セラミック発振子	CSTLS_G 他 4MHz	1	muRata (C内蔵タイプ) (代替可)	X1
4	赤外発光ダイオード	SLR-932AV-7 他	1	SANYO (945nm) (代替可)	D1
5	電解コンデンサ	16V-100μF	1		C1
6	積層セラミックコンデンサ	0.1μF	1		C2
7	カーボン抵抗		1		R1
8	カーボン抵抗		1		R2
9	カーボン抵抗	200Ω 1/6W	1		R3
10	カーボン抵抗	20KΩ 1/6W	1		R4
11	コネクタ	2.5mmピッチ 2P	1		CN1
12	タクトスイッチ		3		SW1,2,3

## 送信



初版 機種追加  
2006.07.22- 2010.11.01

わたなべ企画

IRtSBe参考回路図

IRt2SBe参考回路図

IRt3SBe参考回路図

IRtBSBe参考回路図

赤外線出力

バイナリ入力  
GP1---bit0(SW1)  
GP2---bit1(SW2)  
GP3---bit2(SW3)

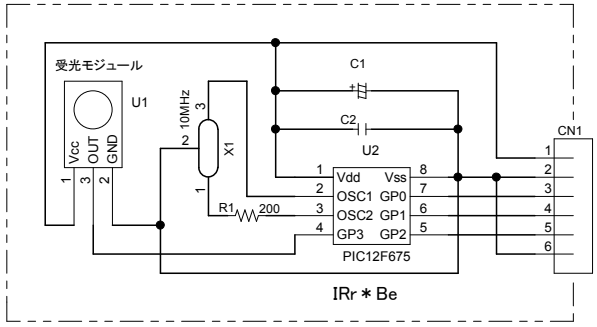
- ◆ X1 : 4MHz厳守!
- ◆ Q1, R1, (R2) : 光出力を調整。(940~950nm)
- ◆ GP1,GP2はプルアップ抵抗が内蔵(50KΩ程度)されていますが不足の場合は外部に追加接続を行ってください。
- ◆ GP3は必要に応じ※保護ダイオードを追加してください。
- ◆ 3V~5動作

※IRt3SBe, IRtBSBeの入力読み込みタイミング  
30msecのスキラン周期+データブロック送信タイム  
SW(入力)の同時押しは、30msecのスキラン周期内の場合は、優先度の高い入力(SW1→3)を採用。送信中の複数入力は、1データブロック送信後、優先度の高い入力(SW1→3)を採用(IRt3SBe)

※本図は参考回路図です。お客様の責任でお使い下さい。商品化される場合はお客様にて設計を行ってください。

No	品名・名称	型格・コード	数量		
1	マイクロプロセッサ	IRr * SBe (PIC12F675)	1	わたなべ企画(マイクロチップテクノロジー)	U2
2	赤外線受光モジュール	PL-IRM0101-3 他	1	(代替可)	U1
3	セラミック発振子	CSTLS_G 他 10MHz	1	muRata (C内蔵タイプ) (代替可)	X1
4	コネクタ	2.5mmピッチ 6P	1		CN1
5	電解コンデンサ	16V-100μF	1		C1
6	積層セラミックコンデンサ	0.1μF	1		C2
7	カーボン抵抗	200Ω 1/6W	1		R1

## 受信



**ご注意!**  
マイコンは3~5Vで動作しますが、添付する受光モジュールは5V用です。

初版 機種追加  
2006.07.22- 2010.11.01

わたなべ企画

IRrBe参考回路図

IRr2Be参考回路図

IRr3Be参考回路図

IRrBBe参考回路図

+5V  
GND  
OUT-1(SW1の出力/bit0出力)  
OUT-2(SW2の出力/bit1出力)  
OUT-3(SW3の出力/bit2出力)  
COM

- ◆ X1 : 10MHz厳守!
- ◆ GP0, 1, 2はプルアップ内蔵(50KΩ程度)不足の場合は外部プルアップを追加してください。
- ◆ 受光モジュールはプルアップ内蔵品を使用した場合の接続です。添付するモジュールにより端子配列が異なります。ご注意ください。

※本図は参考回路図です。お客様の責任でお使い下さい。商品化される場合はお客様にて設計を行ってください。